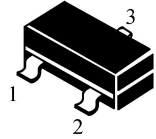




GMA733

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■FEATRUES 特點

PNP General Purpose Transistor

■MAXIMUM RATINGS (T<sub>a</sub>=25°C) 最大額定值

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V <sub>CBO</sub>	-60	Vdc
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V <sub>CEO</sub>	-50	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V <sub>EBO</sub>	-5.0	Vdc
Collector Current-Continuous 集電極電流-連續	I <sub>c</sub>	-150	mA
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P <sub>C</sub>	225	mW
Junction Temperature 結溫	T <sub>j</sub>	150	°C
Storage Temperature Range 儲存溫度	T <sub>stg</sub>	-55~150	°C

■DEVICE MARKING 打標

GMA733(A733LT1)=CS  
H<sub>FE</sub>:120-220 200-475

GMA733

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

( $T_A=25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise noted 如無特殊說明,溫度為  $25^{\circ}\text{C}$ )

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=-60\text{V},$ $I_E=0$	—	—	-0.1	$\mu\text{A}$
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=-5\text{V},$ $I_C=0$	—	—	-0.1	$\mu\text{A}$
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=-100\mu\text{A}$	-60	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-1.0\text{mA}$	-50	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-100\mu\text{A}$	-5	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	$H_{FE}$	$V_{CE}=-6\text{V},$ $I_C=-1\text{mA}$	120	—	475	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-100\text{mA},$ $I_B=-10\text{mA}$	—	—	-0.3	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基極-發射極飽和壓降	$V_{BE(sat)}$	$I_C=-100\text{mA},$ $I_B=-10\text{mA}$	—	—	-1.0	V
Base-Emitter Saturation 基極-發射極電壓	$V_{BE}$	$V_{CE}=-5.0\text{V},$ $I_C=-10\text{mA}$	—	—	-0.8	V
Transition Frequency 特徵頻率	$f_T$	$V_{CE}=-6.0\text{V},$ $I_C=-1\text{mA}$	—	250	—	MHz